

高灵敏度锁存型霍尔传感器系列

1. 产品特性

- 锁存型开关霍尔
- 宽工作电压范围：2.8-40V
- 电源端瞬态耐压 60V（串接 200 欧电阻）
- 宽工作温度范围：-55-150℃
- 反向保护电源电压：-28V
- 开漏输出限流点：40mA
- AEC-Q100 认证
- 高抗电磁干扰和静电防护能力
- 小封装
 - 3 脚 TO92S(UA)
 - 3 脚 SOT23-3L(SO)

2. 产品应用

- 无刷电机位置传感器
- 座椅电机
- 升降窗
- 天窗/尾门开关转速表

3. 产品描述

SC294X 系列采用高频斩波技术，在全工作电压和工作温度范围内具有很高的磁场一致性和对称性。芯片的输出脚集成了过流保护功能。芯片还具备抗电磁干扰能力强（EMC）和高可靠性的特点。

SC294X 内部集成了稳压模块、霍尔阵列、放大电路、迟滞比较器和输出级等电路模块。霍尔信号处理通路采用高频斩波技术，不但减小了霍尔感应阵列和处理电路的失调电压，而且减小了应力和温度对失调电压的影响，并尽可能地将芯片的系统延时及输出抖动降低至最小。

内部集成的稳压电路使芯片可接受 2.8V 到 40V 的宽电源供电电压，满足工业和汽车电子的应用需求。SC294X 提供小型 3 脚直插封装 TO92S(UA)和 3 脚 SOT23-3L(SO)封装，100% 无卤绿色框架，符合环保要求。

Not To Scale



3 pin TO-92S(UA)



3 pin SOT23-3L(SO)

图 1：封装外形图

目录

1. 产品特性	1	10. 特性曲线	8
2. 产品应用	1	11. 功能框图	10
3. 产品描述	1	12. 功能描述	10
4. 引脚描述	3	12.1. 磁场方向定义	11
5. 订购信息	4	12.2. 传输函数	11
6. 极限参数	5	13. 典型应用	12
7. 静电保护	5	14. 封装信息“UA”	13
8. 热特性	5	15. 封装信息“SO”	14
9. 工作参数	6	16. 历史版本	15
9.1. 电参数	6		
9.2. 磁参数	7		

4. 引脚描述

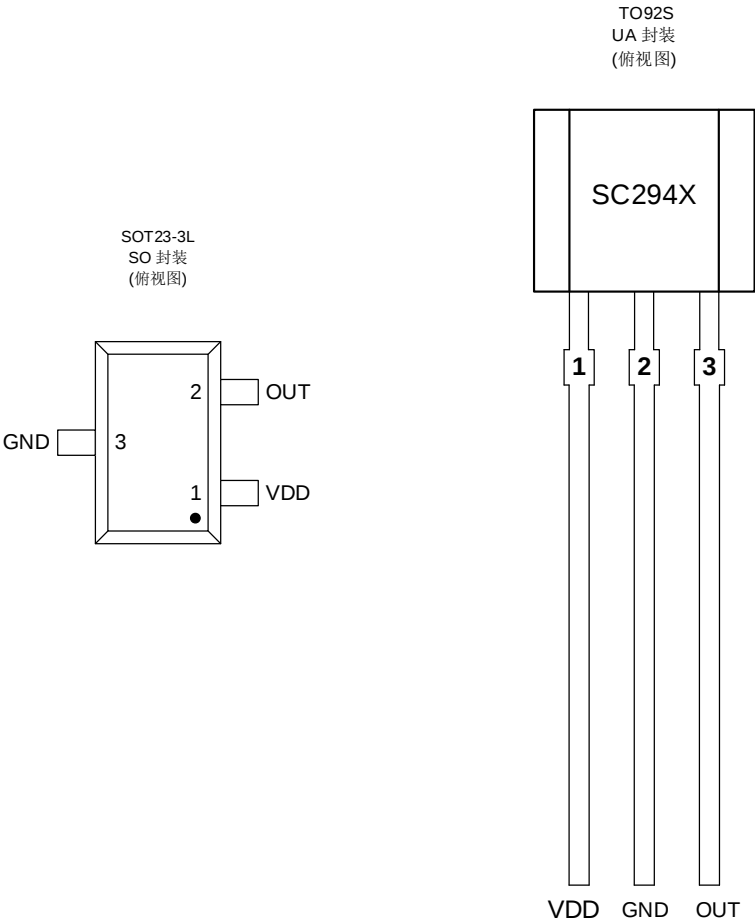


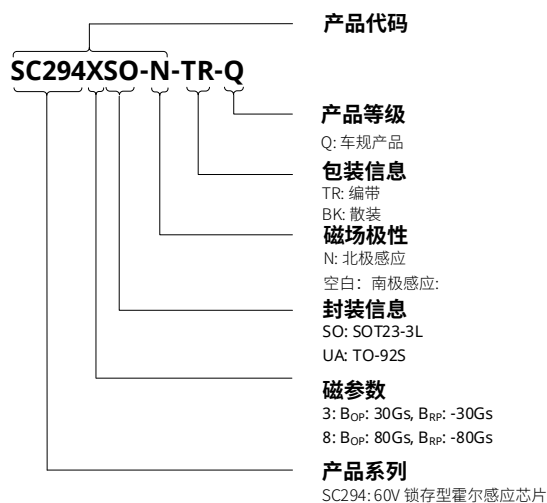
图 2：引脚定义图

引脚			类型	描述
名称	UA	SO		
V _{DD}	1	1	电源	2.8V ~ 40V 电源电压
GND	2	3	地	接地
OUT	3	2	输出	漏极开路输出，使用时需外接上拉电阻

5. 订购信息

产品代码	丝印	等级	温度范围(°C)	封装外形	包装方式	数量
SC2943SO-TR-Q	2943	Q	-55~150	SOT23-3L	编带	3000 颗/盘
SC2943UA-BK-Q	2943	Q	-55~150	TO92S	散包	1000 颗/袋
SC2948SO-TR-Q	2948	Q	-55~150	SOT23-3L	编带	3000 颗/盘
SC2948UA-BK-Q	2948	Q	-55~150	TO92S	散包	1000 颗/袋

订购信息格式说明



6. 极限参数

全工作温度范围(除非另有说明)⁽¹⁾

符号	参数	测试条件	最小值	最大值	单位
V_{DD}	电源端耐压		-28 ⁽²⁾	60	V
V_{OUT}	输出端耐压	1.2K 上拉电阻持续 5 分钟	-0.5	60	V
I_{SINK}	输出灌电流		0	6	mA
T_A	工作温度		-55	150	°C
T_J	最大结温		-55	165	°C
T_{STG}	储藏温度		-65	175	°C

备注

(1) 高于此处列出的压力可能会导致器件永久损坏，长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。

(2) 60V 电源端串接 200ohm 电阻持续 5 分钟

(3) 1.2K 上拉电阻持续 5 分钟

(4) 最长 168 小时

7. 静电保护

符号	参数	测试条件	最小值	最大值	单位
V_{ESD_HBM}	静电防护 (HBM)	人体模型(HBM)测试按照 AEC-Q100-002 标准	-8	8	KV
V_{ESD_CDM}	静电防护 (CDM)	充电器件模型(CDM) 测试按照 AEC-Q100-011 标准	-750	750	V

8. 热特性

符号	参数	测试条件	值	单位
$R_{\theta ja}$	UA 封装热阻	单层 PCB, 覆铜仅限于在焊盘上	166 ⁽¹⁾	°C/W
$R_{\theta ja}$	SO 封装热阻	单层 PCB, 覆铜仅限于在焊盘上	228 ⁽¹⁾	°C/W

备注:

(1)最大工作电压必须满足功耗和结温的要求，参照热特性

9. 工作参数

9.1. 电参数

(VDD = 5.0V, TA = -55°C 到 150°C, 另有说明除外)

符号	参数	测试条件	最小值	典型值 ⁽²⁾	最大值	单位
V _{DD}	工作电压	T _J < T _J (Max.) , I _{DD} =1.2mA	2.8	5	40	V
		T _J < T _J (Max.) , I _{DD} =4.1mA	3.0	-	40	
V _{DDR}	反向耐压	I _{DD} < -10mA, T _A =25°C	-28	-	-	V
UVLO _H	高欠压保护	B > B _{OP} + 2.0mT, VDD Rising From 1.5V, I _{DD} =1.2mA	-	1.75	-	V
		B > B _{OP} + 2.0mT, VDD Rising From 1.5V, I _{DD} =4.1mA	-	1.95	-	mA
UVLO _L	低欠压保护	B > B _{OP} + 2.0mT, VDD Decreasing From 2.5V, I _{DD} =1.2mA	-	1.5	-	V
		B > B _{OP} + 2.0mT, VDD Decreasing From 2.5V, I _{DD} =4.1mA	-	1.7	-	μA
UVLO _{HYS}	欠压保护迟滞	UVLO _H - UVLO _L	-	250	-	mV
I _{DD (off)}	输出关断静态工作电流	V _{DD} =3 to 40 V, T _A =25°C, SC2943SO-N/SC2943UA	-	1.2	-	mA
ton	上电时间	V _{DD} =3 to 40 V, T _A =25°C SC2948SO/SC2948UA	-	4.1	-	mA
t _{on}	上电时间		-	25	40	μS
I _{QL}	关态输出漏电	Output Hi-Z	-	-	3	μA
V _{SAT}	输出低电压	V _{DD} =5V/12V/40V, I _O =20mA, T _A =25°C	-	0.14	0.4	V
		V _{DD} =5V/12V/40V, I _O =30mA, T _A =125°C	-	-	0.5	V
I _O	输出端限流	V _{DD} =5V/12V/40V, V _{OUT} =1V, T _A =25°C		40	60	mA
t _d	输出延迟时间	B=B _{RP} to B _{OP}	-	15	25	μS
t _r	输出上升时间(10% to 90%)	V _{PU} =12V, R _{PU} ⁽³⁾ =1Kohm C _L =50pF	-	0.2	1	μS
t _f	输出下降时间 (90% to 10%)	V _{PU} ⁽³⁾ =12V, R _{PU} =1Kohm C _L =50pF	-	0.1	1	μS

备注

(1) 典型值为在 T_A = +25°C, V_{DD} = 5V 条件下的测试值

(2) 最大工作电压必须满足功耗和热阻的要求

(3) R_{PU} 和 V_{PU} 是外部上拉电阻和外部上拉电压

9.2. 磁参数

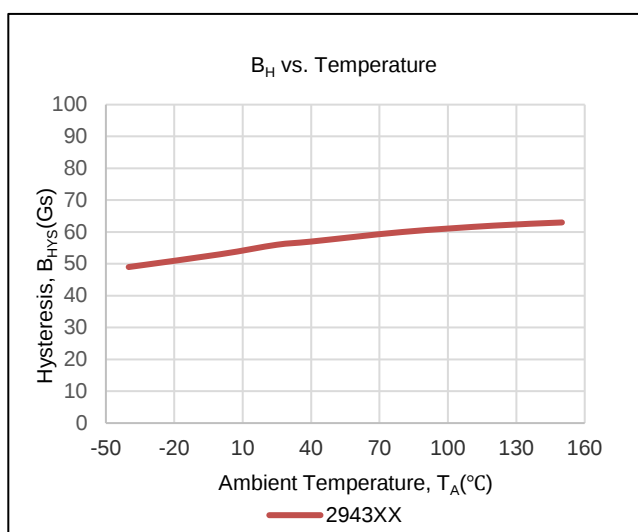
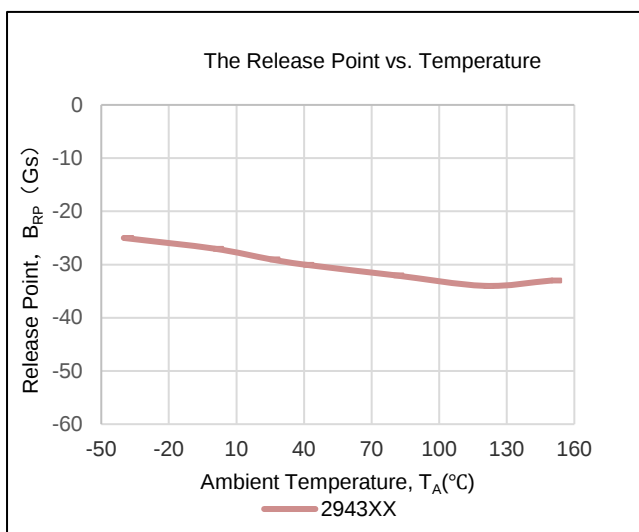
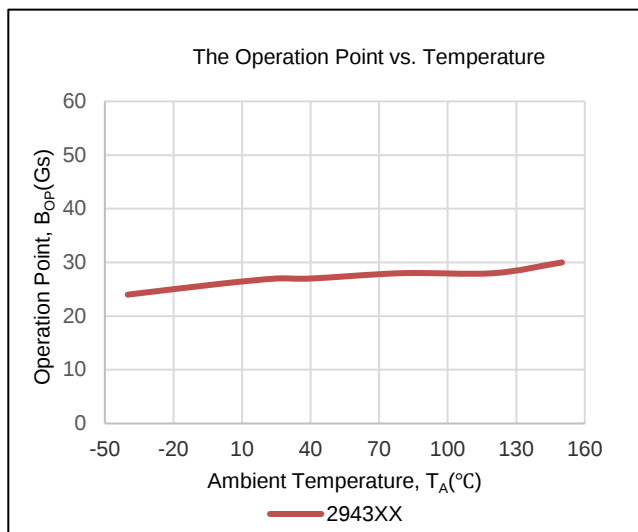
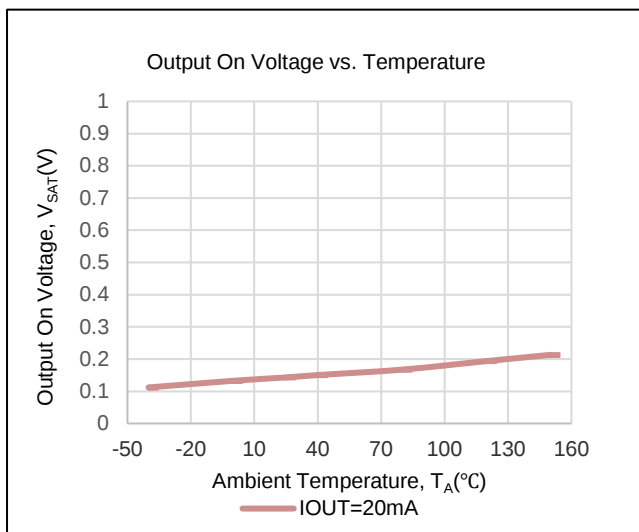
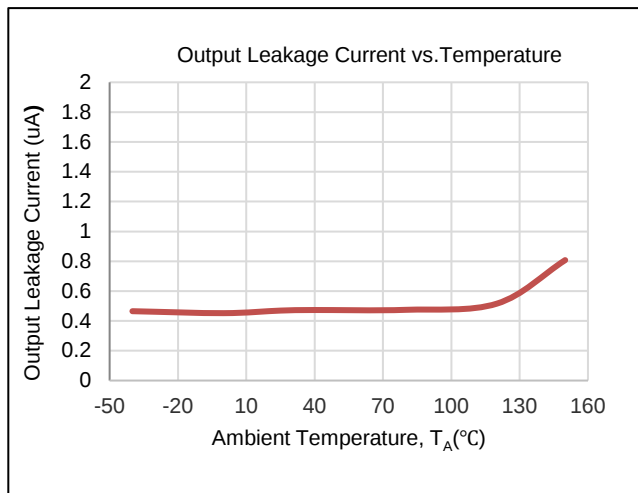
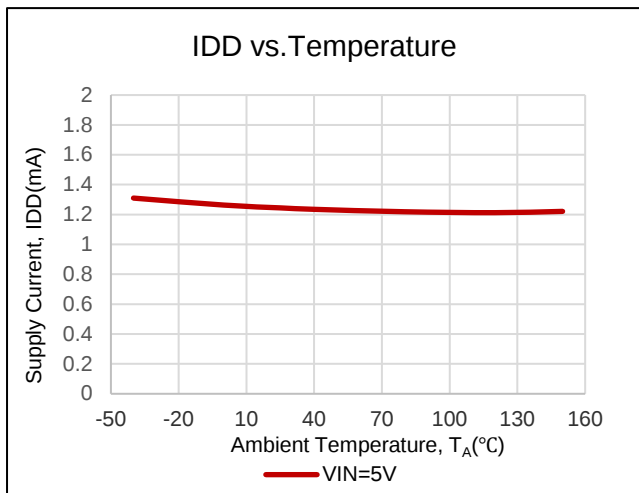
符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
f_{BW}	带宽		20	-	-	KHz
SC2943SO-TR-Q +3.0 / -3.0 mT						
B_{OP}	磁场开启点	$T_A = -55^{\circ}\text{C to } 150^{\circ}\text{C}$	+1.5	+3.0 ⁽²⁾	+4.5	mT ⁽¹⁾
B_{RP}	磁场关闭点		-4.5	-3.0 ⁽²⁾	-1.5	mT
B_{HYS}	迟滞		3.0	6.0	9.0	mT
B_O	磁场对称性	$B_O = (B_{OP} + B_{RP}) / 2$	-1.5	0	+1.5	mT
IDD	输出关断静态工作电流		-	1.2	-	mA
SC2943UA-BK-Q +3.0 / -3.0 mT						
B_{OP}	磁场开启点	$T_A = -55^{\circ}\text{C to } 150^{\circ}\text{C}$	+1.5	+3.0	+4.5	mT
B_{RP}	磁场关闭点		-4.5	-3.0	-1.5	mT
B_{HYS}	迟滞		3.0	6.0	9.0	mT
B_O	磁场对称性	$B_O = (B_{OP} + B_{RP}) / 2$	-1.5	0	+1.5	mT
IDD	输出关断静态工作电流		-	1.2	-	mA
SC2948SO-TR-Q +8.0 / -8.0 mT						
B_{OP}	磁场开启点	$T_A = -55^{\circ}\text{C to } 150^{\circ}\text{C}$	+6.0	+8.0	+10.0	mT
B_{RP}	磁场关闭点		-10.0	-8.0	-6.0	mT
B_{HYS}	迟滞		12.0	16.0	20.0	mT
B_O	磁场对称性	$B_O = (B_{OP} + B_{RP}) / 2$	-2.0	0	+2.0	mT
IDD	输出关断静态工作电流		-	4.1	-	mA
SC2948UA-BK-Q +8.0 / -8.0 mT						
B_{OP}	磁场开启点	$T_A = -55^{\circ}\text{C to } 150^{\circ}\text{C}$	+6.0	+8.0	+10.0	mT
B_{RP}	磁场关闭点		-10.0	-8.0	-6.0	mT
B_{HYS}	迟滞		12.0	16.0	20.0	mT
B_O	磁场对称性	$B_O = (B_{OP} + B_{RP}) / 2$	-2.0	0	+2.0	mT
IDD	输出关断静态工作电流		-	4.1	-	mA

备注

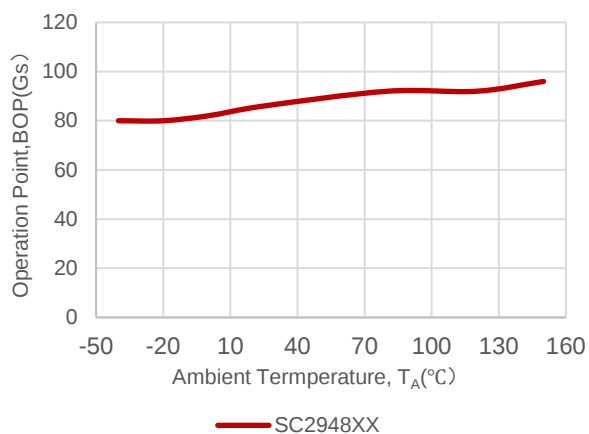
(1) $1\text{mT}=10\text{Gs}$

(2) 磁感应强度B，北极性磁场为负值，南极性磁场为正值。

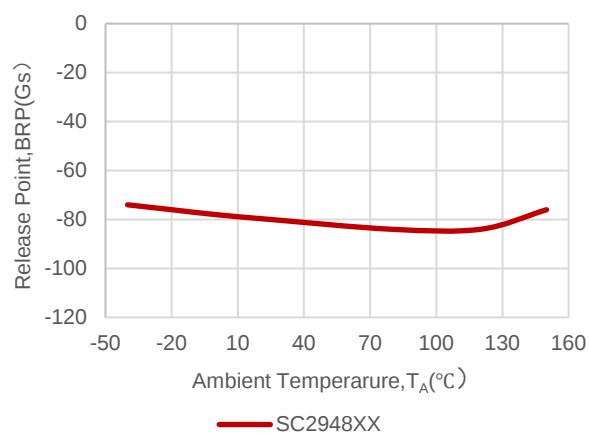
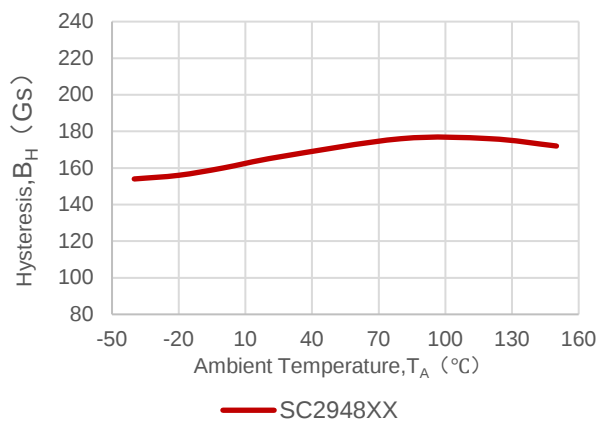
10. 特性曲线



The Operation Point vs. Temperature



The Release Point vs. Temperature

 B_H vs. Temperature

11. 功能框图

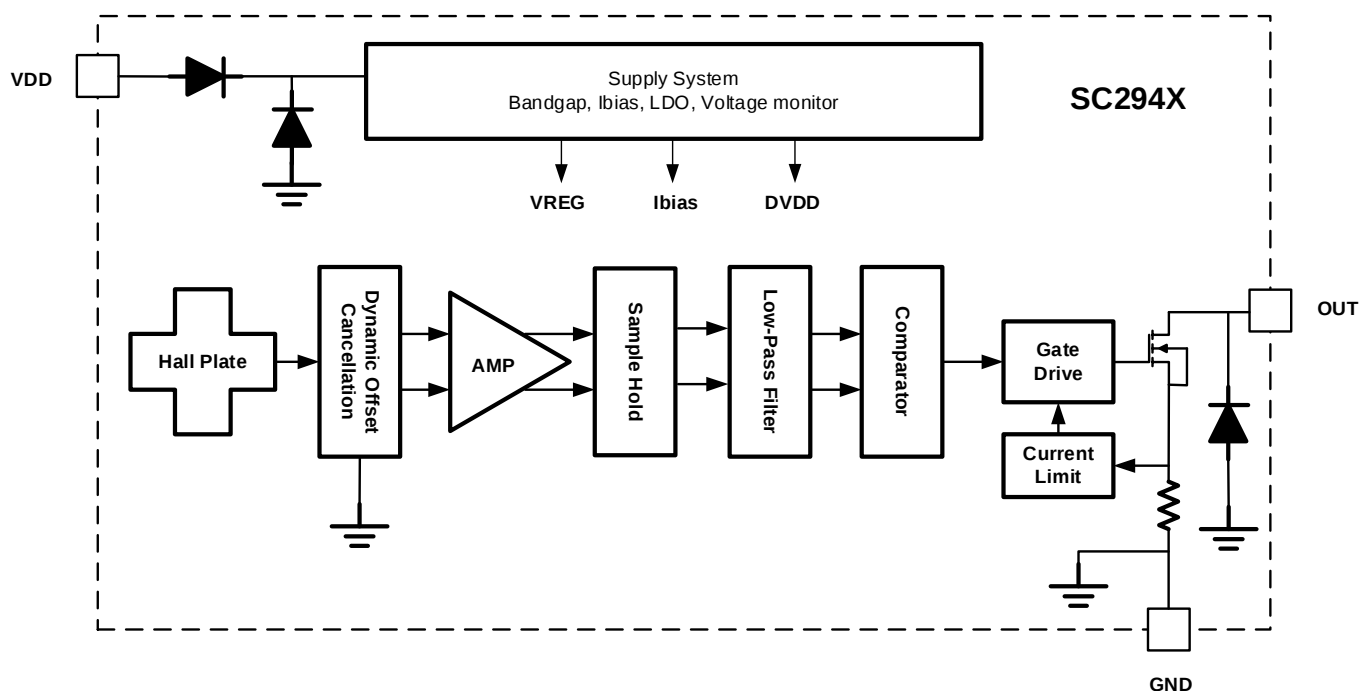


图 3 功能框架图

12. 功能描述

SC294X 芯片是一款应用于磁场感应的具有斩波频率稳定的锁存输出型霍尔传感器。该器件可在 2.8V-40V 的供电电压下工作，并能持续承受-28V 的反向电源电压条件。

当垂直作用于霍尔元件的磁场强度的绝对值超过工作点阈值时, SC294X 输出低电平(开启), 输出端可灌电流 20mA, 输出电压为饱和电压 $V_{Q(sat)}$ 。当磁场强度降低超过释放点 BRP 的绝对值时, 器件输出高电平(关断)。磁场工作点和释放点的差异即为器件的磁滞 BHYS, 这种内部的迟滞使器件可以免受外部机械振动和电气噪声的干扰。

12.1. 磁场方向定义

磁场 S 极正对芯片丝印面定义为正磁场。

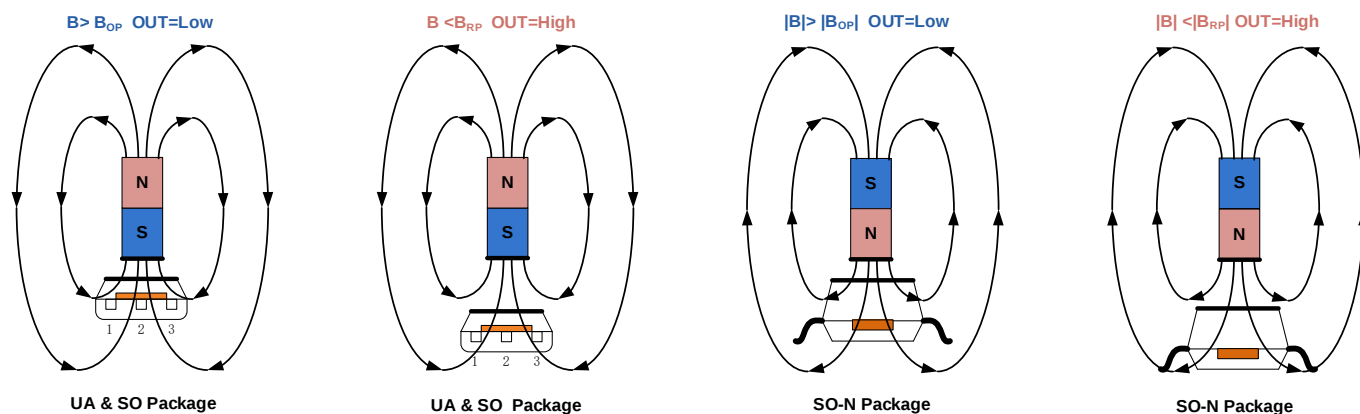


图 4：磁场方向定义图

12.2. 传输函数

在迟滞区通电，小于 B_{OP} ，大于 B_{RP} ，允许不确定的输出状态。在第一次超出 B_{OP} 或 B_{RP} 之后，就可以达到正确的状态。如果电场强度大于 B_{OP} ，则输出被拉低。如果电场强度小于 B_{RP} ，输出被释放。

B_{OP} —磁阈值的激活设备输出，在接通(低)状态

B_{RP} —磁阈值释放设备输出，关(高)状态。

$$B_{HYS} = B_{OP} - B_{RP}$$

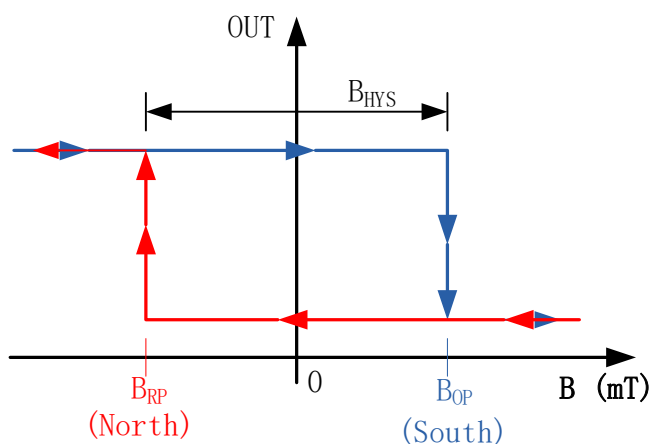


图 5：传输曲线图

13. 典型应用

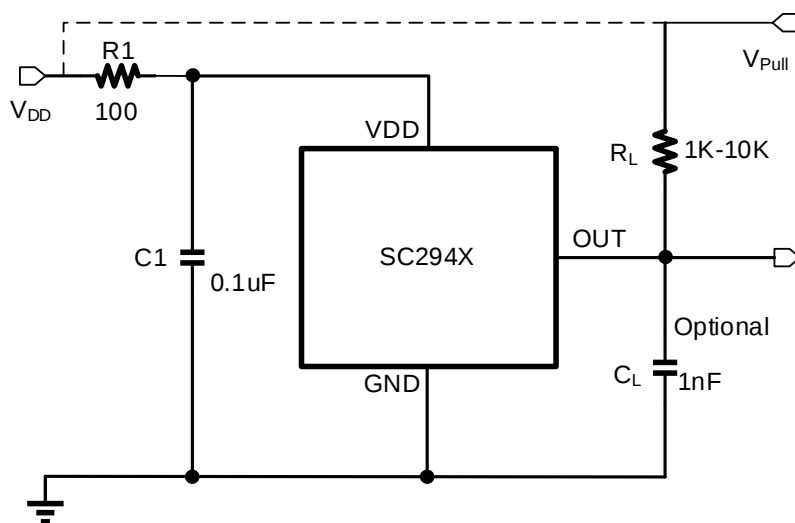


图 6：典型应用线路图

SC294X 内部有电压调节器，可以在宽供电电压范围内工作。当器件工作于非稳压电源供电的应用时，必须在外部添加瞬态保护。对于使用稳压电源线路供电的应用，仍然推荐设计 EMI/RFI 保护。强烈建议电源端与接地端使用外接电容，可降低外部噪声及内部斩波频率技术产生的噪声，建议靠近芯片 VDD 电源端并联 C1 电容到地，其典型值为 0.1μF。同时在外部可选配串联电阻 R1 其典型值为 100Ω。输出电容 CL 用作输出滤波，典型值为 1nF。

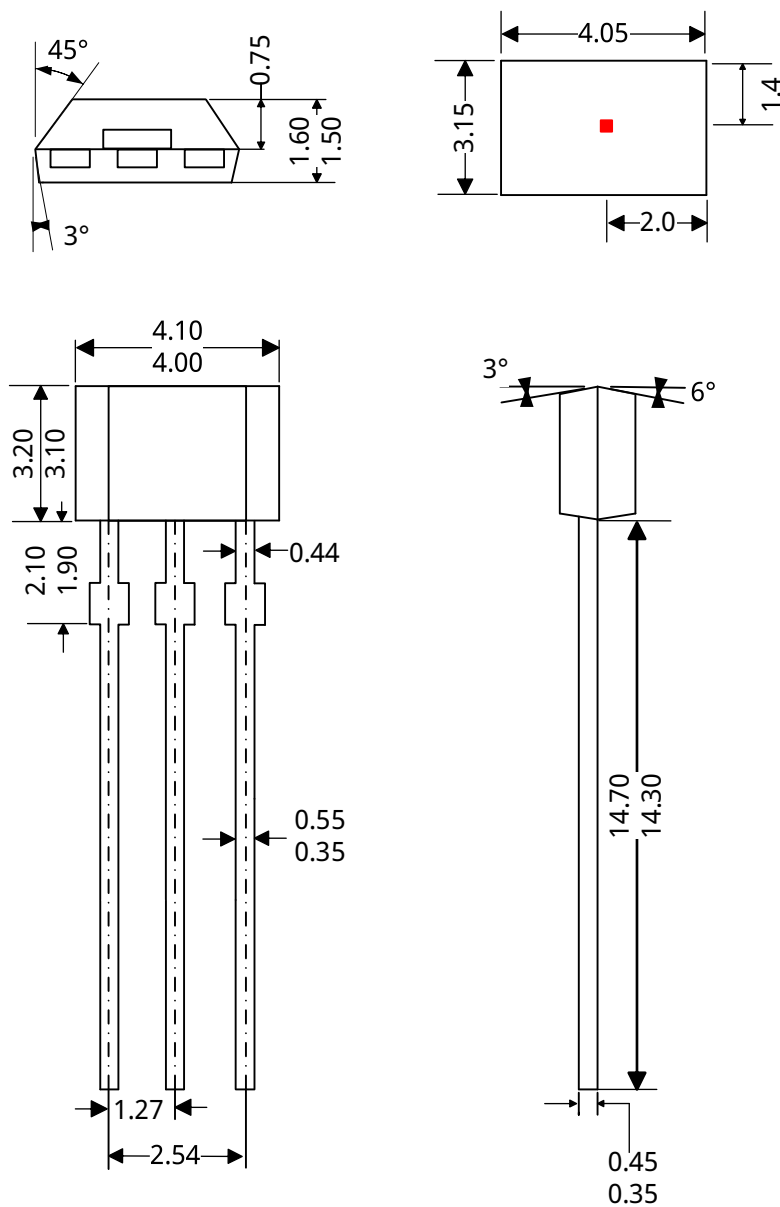
根据系统带宽规范和如下公式选择一个 CL 值：

$$C_L < \frac{1}{2\pi \times R_L \times 2 \times f_{BW} (Hz)}$$

14. 封装信息 “UA”

3-脚
S1 封装

单位：毫米



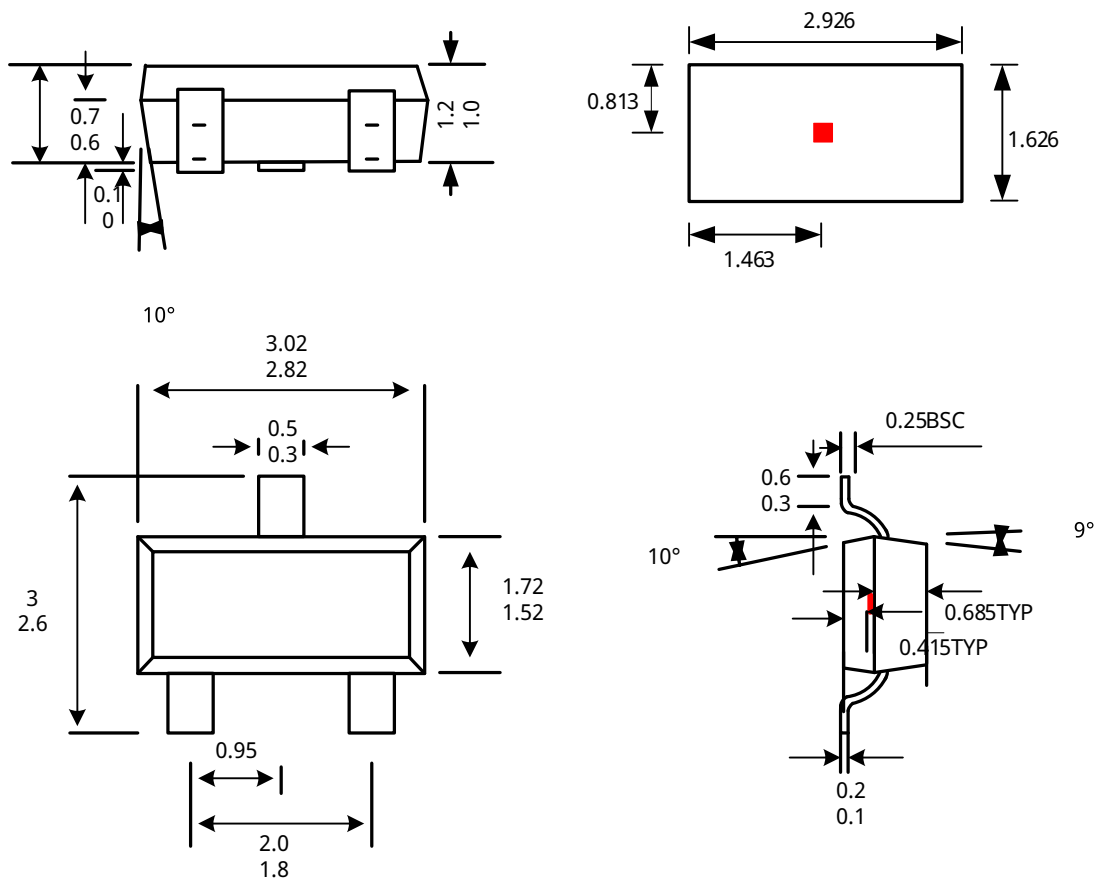
注：

- 1、供应商可选的实际本体和管脚形状、尺寸位于图示范围内
 - 2、高度不包括模具浇口溢料
- 若未指定公差，则尺寸为公称尺寸

15. 封装信息 “SO”

3-脚
SO封装

单位: mm



注:

1. 供应商可选的实际本体和管脚形状尺寸位于图示范围内。
 2. 高度不包括模具浇口溢料。
- 如果未指定公差，则尺寸为公称尺寸。

16. 历史版本

版本号	日期	修改说明
Rev. E0.1	2024-05-02	初始版本
Rev. A1.0	2024-10-26	统一规格发布